DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

12693202

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 7258410 A2 951009 < No. of Patents: 001>

POLYIMIDE-SILOXANE (English)
Patent Assignee: UBE INDUSTRIES

Author (Inventor): INOUE HIROSHI; TAKABAYASHI SEIICHIRO; MURAMATSU TADAO;

SONOYAMA KENJI

IPC: \*C08G-073/10; C08L-079/08; C08L-083/10 CA Abstract No: \*124(08)088922Q; 124(08)088922Q Derwent WPI Acc No: \*C 95-380153; C 95-380153

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 7258410 A2 951009 JP 9448671 A 940318 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 9448671 A 940318

# © UROPEAN PATENT OFFICE

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07258410

PUBLICATION DATE

09-10-95

APPLICATION DATE

18-03-94

APPLICATION NUMBER

06048671

APPLICANT: UBE IND LTD;

INVENTOR: SONOYAMA KENJI;

 $H_2 N-R = \begin{bmatrix} R_1 \\ S_i \\ R_2 \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} R_2 \\ S_i \\ R_3 \end{bmatrix} = R-NH_2$ 

INT.CL.

: C08G 73/10 C08L 79/08 C08L 83/10

TITLE

: POLYIMIDE-SILOXANE

ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a polyimide-siloxane highly soluble to low-boiling solvents, excellent in heat resistance and chemical, resistance, and suitable for e.g. surface-protective films for electrical and electronic parts, by polymerization between each specific aromatic tetracarboxylic acid component and diamine component to effect imidation.

> CONSTITUTION: This polymeric compound is obtained by polymerization between (A) an aromatic tetracarboxylic acid component consisting mainly of a 3,3',4,4'biphenyltetracarboxylic acid (pref. blended with ≤25mol% of 2,3,3',4'biphenyltetracarboxylic dianhydride) and (B) a diamine component composed of 45-85mol% of a diaminopolysiloxane of the formula (R is a divalent hydrocarbon residue;  $R_1$ - $R_4$  each is a lower alkyl or phenyl; (n) is 3-40) and 15-55mol% of an aromatic diamine having two or more aromatic rings [a combination of pref. ω,ω'-bis(2-aminoethyl) polydimethylsiloxane with 4,4'-diaminodiphenyl ether], to effect imidation.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

# (19)日本国特許庁(JP)

# 四公開特許公報 四

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-258410

(43)公開日 平成7年(1995)10月9日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

C08G 73/10

NTF

CO8L 79/08

LRC

83/10

LRR

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平6-48671

(71)出願人 000000206

宇部興産株式会社

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

(22)出願日

平成6年(1994)3月18日

(72) 発明者 井上 浩

大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産

株式会社枚方研究所内

(72)発明者 高林 誠一郎

大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産

株式会社枚方研究所内

(72)発明者 村松 忠雄

大阪府枚方市中宮北町3番10号 宇部興産

株式会社枚方研究所内

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】ポリイミドシロキサン

### (57) 【要約】

【目的】 有機溶媒への可溶性、耐熱性及び耐薬品性を有すると共に電気絶縁性を有するので電気・電子部品の表面保護膜や層間絶縁膜、銅箔と基材間の接着剤成分として使用できる。

【構成】 3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸類を主成分とする芳香族テトラカルボン酸成分とジアミノポリシロキサン45~85モル%及び複数の芳香族環を有する芳香族ジアミン15~55モル%からなるジアミン成分とを重合及びイミド化することにより得られる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 3,3',4,4'-ピフェニルテトラカル ポン酸類を主成分とする芳香族テトラカルポン酸成分と

$$H_{i} N-R = \begin{bmatrix} R_{i} \\ S_{i} \\ R_{i} \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} R_{i} \\ S_{i} \\ R_{i} \end{bmatrix} = R-NH_{i}$$
 (1)

(但し、式中のRは2価の炭化水素残基を示し、R,、 R、、R、及びR、は低級アルキル基又はフェニル基を 示し、nが3~40の整数を示す)で示されるジアミノ ポリシロキサン45~85モル%及び複数の芳香族環を 有する芳香族ジアミン15~55モル%からなるジアミ ン成分とを(b) 重合及びイミド化することにより得ら れることを特徴とするポリイミドシロキサン。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】この発明は、可溶性、耐熱性及び 耐薬品性を有すると共に電気絶縁性を有する電気・電子 部品用表面保護膜、層間絶縁膜及び銅箔と基材間の接着 剤成分として有用な特殊なポリイミドシロキサンに関す 20 るものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、芳香族ポリイミドなどを電気絶縁 性の保護膜及び耐熱性接着剤の主成分として利用するこ とは 、例えば、フレキシブル配線板、半導体集積回路 などの層間絶縁膜や銅箔と基材間の接着剤組成物などの 用途において、既に種々知られている。しかしながら、 一般に芳香族ポリイミドは、有機溶媒に溶解しないの で、芳香族ポリイミドの前駆体(芳香族ポリアミック 酸) の溶液として使用して、塗布膜を次いで、乾燥とイ 30 ミド化を高温で長時間、加熱処理することによって、保 護膜にする必要があり、保護すべき電気又は電子部材自 体が熱的な劣化を起こすという問題があった。一方、特 公昭57-41491号公報には有機溶媒に可溶性の芳 香族ポリイミドが開示されているが、シリコンウエハ ー、ガラス板、フレキシブル配線基板などとの密着性が 充分でないので、予め基板などを密着促進剤で処理して おくなどの方法が必要であった。

【0003】前述の問題点を解決するために、ジアミン 成分としてジアミノポリシロキサンを使用したポリイミ ドシロキサンの前駆体が例えば、特開昭57-1433 28号公報、特開昭58-13631号公報に開示され ているが、これらのポリイミドシロキサンの前駆体はイ ミド化するためには髙温で処理しなければならないとい う欠点を有していた。

【0004】又、特開昭61-118424号公報、特 開昭61-207438号公報、特開昭63-2256 29号公報、特開平1-121325号公報には可溶性 10 ポリイミドシロキサンが開示されている。しかし、これ らのポリイミドシロキサンは、その製造工程が数段階に 及び、製造に長時間を要するという問題があったり、ジ アミン成分として芳香族ジアミンを全く含んでおらず、 耐熱性が低いという問題、種々の有機溶媒に対する溶解 性が必ずしも充分でないという問題、フレキシブル配線 基板などに塗布して乾燥した場合に、その基板が大きく カールするという問題などがあった。

【0005】更に、特開平4-23833号公報、特開 平4-36321号公報の可溶性ポリイミドシロキサン は、フレキシブル配線基板、半導体集積回路などの層間 絶縁膜や銅箔と基材間の接着剤組成物などの用途に使用 した場合に、製造工程でのアセトンを使用した洗浄工程 で溶解するという問題があった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、特 定の低沸点溶媒に対して高い溶解性、耐熱性を有すると 共に、耐薬品性も良好で、その製造工程が容易なポリイ ミドシロキサンを提供することである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】この発明者らは、上記の 課題を改良することを目的として鋭意研究を行って、3. 3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸類を主成分とする 芳香族テトラカルボン酸成分とジアミノポリシロキサン 45~85モル%及び複数の芳香族環を有する芳香族ジ アミン15~55モル%からなるジアミン成分とを重合 及びイミド化することにより得られるポリイミドシロキ サンが、特定の低沸点溶媒に対して高い溶解性、耐熱性 を有すると共に、耐薬品性も良好で、その製造工程が容 40 易なことを知り、この発明に至った。

【0008】この発明は、(a)3,3',4,4'-ピフェニル テトラカルボン酸類を主成分とする芳香族テトラカルボ ン酸成分と一般式(1)

[0009]

【化2】

$$H_{\bullet} N - R = \begin{bmatrix} R_{\bullet} \\ S_{\bullet} \\ R_{\bullet} \end{bmatrix} = 0 = \begin{bmatrix} R_{\bullet} \\ S_{\bullet} \\ R_{\bullet} \end{bmatrix} = R - NH_{\bullet}$$
 (1)

[0010] (但し、式中のRは2価の炭化水素残基を 50 示し、R, 、R, 、R, 及びR, は低級アルキル基又は

フェニル基を示し、nが3~40の整数を示す)で示さ れるジアミノポリシロキサン45~85モル%及び複数 の芳香族環を有する芳香族ジアミン15~55モル%か らなるジアミン成分とを(b) 重合及びイミド化するこ とにより、得られることを特徴とするポリイミドシロキ サン。

【0011】この発明において、ビフェニルテトラカル ボン酸類を主成分とする芳香族テトラカルボン酸成分に 対して30モル%以下、特に25モル%以下の割合で、 3,3',4,4'-ピフェニルテトラカルボン酸と共に使用する 10 ことができる他の芳香族テトラカルボン酸成分として は、2,3,3',4'-ピフェニルテトラカルボン酸類、3,3', 4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸類、3,3',4,4'-ピフェニルエーテルテトラカルボン酸類、ピロメリット 酸類などが使用される。これらの中でも特に、2,3,3', 4'-ピフェニルテトラカルボン酸二無水物が、前記ポリ イミドシロキサンの有機極性溶媒に対する溶解性、エポ キシ化合物との相溶性などに優れているので好適であ

【0012】この発明において、ピフェニルテトラカル 20 ポン酸類と共に使用することができる芳香族テトラカル ボン酸成分としては、例えば、3,3',4,4'-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸、3,3',4,4'-ジフェニルエーテルテ トラカルボン酸、ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル) メ タン、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパ ン、ピロメリット酸、又はそれらの酸二無水物やエステ ル化物等を好適に挙げることができる。しかし、これら の使用量が多すぎると、前記ポリイミドシロキサンが有 機極性溶媒に対して難溶性となったり、エポキシ樹脂と の相溶性が悪化したりするので適当ではない。

【0013】この発明において、一般式(1)で示され るジアミノポリシロキサンとしては、式中のRが炭素数 2~6個、特に3~5個の『複数のメチレン基』、又は フェニレン基からなる2価の炭化水素残基であり、R<sub>1</sub> ~R, がメチル基、エチル基、プロピル基等の炭素数1 ~5の低級アルキル基又はフェニル基であることが好ま しく、更に、nが4~20の整数、特に5~20、更に 好ましくは5~15程度であることが好ましい。R、R , ∼R, の炭素数が多すぎたり、nの数が大きすぎると 反応性が低下したり耐熱性が悪くなったり、得られるポ 40 リイミドシロキサンの分子量が低くなったり有機溶媒に 対する溶解性が低下したり、他の有機化合物との相溶性 が悪くなったりするので前記程度のものが適当である。 【0014】一般式(1)で示されるジアミノポリシロ キサンの具体的種類としては、ω,ω'-ビス(2-アミ

ノエチル) ポリジメチルシロキサン、ω,ω'-ビス(3 - アミノプロピル) ポリジメチルシロキサン、ω,ω' - ビス(3- アミノブチル) ポリジメチルシロキサン、 ω, ω' - ピス(3- アミノプロピル) ポリメチルフェニ

リジメチルシロキサン、ω,ω'- ピス(4- アミノ-3-メチルフェニル) ポリジメチルシロキサン、ω, ω'-ビス(3- アミノプロピル) ポリジフェニルシロキサン等 を好適に挙げることができる。

【0015】また、ジアミノポリシロキサンと共に使用 される芳香族ジアミンとしては、一般にはベンゼン環等 の芳香族環を2個以上、特に2~5個有する芳香族ジア ミン化合物、例えばピフェニル系ジアミン化合物、ジフ ェニルエーテル系ジアミン化合物、ベンゾフェノン系ジ アミン化合物、ジフェニルスルホン系ジアミン化合物、 ジフェニルメタン系ジアミン化合物、ジフェニルプロパ ン系ジアミン化合物、ジフェニルチオエーテル系ジアミ ン化合物、 ピス (フェノキシ) ペンゼン系ジアミン化 合物、ピス(フェノキシフェニル)スルホン系ジアミン 化合物、ビス(フェノキシ)ジフェニルスルホン系ジア ミン化合物、ピス(フェノキシフェニル)ヘキサフルオ ロプロパン系ジアミン化合物、ビス(フェノキシフェニ ル) プロパン系ジアミン化合物等を挙げることができ、 それらを単独、或いは、混合物として使用することがで きる。

【0016】前記芳香族ジアミンの具体的種類として は、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,3'-ジアミ ノジフェニルエーテル等のジフェニルエーテル系ジアミ ン化合物、1,3-ピス(3- アミノフェノキシ) ベンゼン、 1,4-ピス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン等のピス(フ エノキシ) ベンゼン系ジアミン化合物、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン等のビス( フェノキシフェニル) プロパン系ジアミン化合物、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] スルフォン、ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルフォン等のビ ス(フェノキシフェニル)スルフォン系ジアミン化合物 等の芳香族環を2~5個有する芳香族ジアミン化合物を 好適に挙げることができる。

【0017】この発明のポリイミドシロキサンにおい て、ジアミノポリシロキサンと芳香族ジアミンは、前者 が45~85モル%、好ましくは45~80モル%、更 に好ましくは45~75モル%、後者が15~55モル %、好ましくは20~55モル%、更に好ましくは25 ~55モル%の割合で使用される。どちらかの成分が少 なすぎたり、多すぎたりしてこれらの範囲をはずれると ポリイミドシロキサンの有機溶剤に対する溶解性が低下 したり、他の有機化合物との相溶性が悪くなったり、フ レキシブル配線板上に保護膜を形成する際に大きくカー ルしたり、又は耐熱性、機械特性などが低下するので適 当でない。

【0018】この発明において、(a)成分のポリイミ ドシロキサンは、次の方法で製造される。 香族テトラカルボン酸成分とジアミノポリシロキサン及 ルシロキサン、ω,ω'- ピス(4- アミノフェニル) ポ 50 び芳香族ジアミンのジアミン成分とを、略等モル使用し

て有機極性溶媒中で連続的に温度15~250°Cで重 合及びイミド化させてポリイミドシロキサンを得る方 法。

【0019】(a<sub>2</sub>) ジアミン成分を分けて、まず芳香 族テトラカルボン酸成分の過剰量とジアミノポリシロキ サンとを有機極性溶媒中で温度15~250°Cで重合 及びイミド化させて、平均重合度1~30、好ましくは 1~20程度の末端に酸又は酸無水物基を有するイミド シロキサンオリゴマーを調製し、別に芳香族テトラカル ポン酸成分と過剰量の芳香族ジアミンとを有機極性溶媒 10 中で温度15~250°Cで重合、及びイミド化させ て、平均重合度1~30、好ましくは1~20程度の末 端にアミノ基を有するイミドオリゴマーを調製し、次い でこの両者を酸成分とジアミン成分とが略等モルになる ように混合して温度15~60° Cで反応させて、更に 温度を130~250°Cに昇温してプロックタイプの ポリイミドシロキサンを得る方法。

【0020】(a,) 芳香族テトラカルボン酸成分とジ アミノポリシロキサン及び芳香族ジアミン成分とを略等 モル使用して、有機極性溶媒中でまず温度20~80° Cで重合させて一度ポリアミック酸を得た後に、イミド 化してポリイミドシロキサンを得る方法等がある。

【0021】この発明でポリイミドシロキサンの製造に 使用される有機極性溶媒としては、例えば、N.N-ジメチ ルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N, N-ジメ チルホルムアミド、N, N-ジエチルホルムアミド、N-メチ ルー2-ピロリドン等のアミド系溶媒、ジメチルスルホキ シド、ジエチルスルホキシド、ジメチルスルホン、ジエ チルスルホン、ヘキサメチルスルホルアミド等の硫黄原 子を含有する溶媒、クレゾール、フェノール、キシレノ 30 ールなどのフェノール系溶媒、アセトン、メタノール、 エタノール、エチレングリコール、ジオキサン、テトラ ヒドロフラン等の酸素原子を分子内に有する溶媒、ピリ ジン、テトラメチル尿素等のその他の溶媒を挙げること ができる。更に、必要に応じて、ベンゼン、トルエン、 キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、ソルベントナフ サ、ベンゾニトリルのような他の種類の有機溶媒を併用 することも可能である。

【0022】この発明において、ポリイミドシロキサン は前記 (a<sub>1</sub>)~ (a<sub>1</sub>)等いずれの方法で得られたものを 40 使用してもよいが、できるだけ高分子量でイミド化率が 高く、有機極性溶媒に少なくとも3重量%以上、特に5 ~40重量%程度の高濃度で溶解させることができるも のが、積層操作や積層性能のよい積層板が得られるので 好適である。

【0023】ポリイミドシロキサンのイミド化率は、赤 外線吸収スペクトル分析法で測定してイミド化率が90 %以上、特に95%以上が好ましく赤外線吸収スペクト ル分析においてポリマーのアミドー酸結合に係わる吸収 ピークが実質的に見出されず、イミド環結合に係わる吸 50 収ピークのみが見られるような高いイミド化率であるこ とが好ましい。

【0024】ポリイミドシロキサンは、分子量の目安と しての対数粘度(測定濃度:0.5g/100ミリリッ トル溶液、溶媒:N-メチル-2-ピロリドン、測定温度: 30°C、粘度計:キャノンフェンスケ型粘度計)が、 0.05~3、特に0.10~2程度であるのが適当で

【0025】以下に実施例及び比較例を挙げ、この発明 を詳細に説明する。ポリイミドシロキサンの溶解性は、 ポリイミドシロキサン粉末0.2gを20°Cでテトラ ヒドロフラン及びアセトン 0.8gに添加・放置し て、その溶解状態を観察して、1時間以内に溶解した場 合を◎、1日以内に溶解した場合を◎、単に溶媒中に膨 潤する場合を△、1週間でも全く不溶の場合を×、とし て評価した。

#### 【0026】実施例1

温度計、仕込・留出口及び攪拌機を備えた容量2リット ルのガラス製フラスコに、N- メチル-2- ピロリドン( NMP) 1000gを入れ、次いで3, 3', 4, 4' - ピフェニルテトラカルポン酸二無水物 (s-BPD A) 73.56g(250ミリモル)、ω,ω'-ビス (3-アミノプロピル) ポリジメチルシロキサン (東レ・ ダウコーニング・シリコーン社製, BY16-853 U; DAPS) 132g(150ミリモル), 2, 2 -ビス[4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン (BAPP) 41.05g(100ミリモル)を仕込 み、窒素気流中で60°Cの温度に高め、この温度で3 時間反応した。次いで、その反応液を200°Cに昇温 して、その温度で3時間反応した。室温に下げた反応液 を10リットルの水中に添加して、ホモミキサーを使用 して30分間で析出させたポリマーを濾過して、ポリマ 一粉末を単離して、そのポリマー粉末を5リットルの水 中でホモミキサーを使用して15分間の洗浄を2回行 い、120°Cで5時間熱風乾燥してポリイミドシロキ サン粉末、220gを得た。得られたポリイミドシロキ サンは、対数粘度(30°C)は0.26であり、イミ ド化率は実質的に100%であった。

### 【0027】実施例2

容量1リットルのガラス製フラスコに、窒素雰囲気下で NMP 500g、2, 3 , 3', 4 ーピフェニル テトラカルボン酸二無水物 (a-BPDA) 29. 25 g (100ミリモル) とBAPP 82. 11g (20 0ミリモル)を添加して、60°C、2時間反応させ た。更に温度を200°Cに昇温させて水を除去させな がら3時間重合を行いジアミン末端イミドオリゴマー (YO成分)を合成した。更に、容量1リットルのガラ ス製フラスコに、NMP 500gを入れ、次いでs-BPDA 88. 27g (300ミリモル)、DAPS 176g(200ミリモル)を仕込み、窒素気流中で

60°Cの温度に高め、この温度で2時間反応した。次 いで、その反応液を200°Cに昇温して、水を除去し ながらその温度で3時間反応して酸末端イミドオリゴマ ー (X1成分) を合成した。次に、容量2リットルのガ ラス製フラスコに、NMP 100g、YO成分10 7. 93g(100ミリモル)とX1成分 257g (100ミリモル) を加え、窒素下に60°C、2時 間、更に昇温して200° Cで水を除去しながら3時間 反応させた。最後にこの反応液を室温に下げて、10リ ットルの水中に添加してホモミキサーを使用して30分 10 のポリイミドシロキサンの溶解性を第1表に示した。 間でポリマーを析出させて、これを濾過させ、ポリマー 粉末を単離し、そのポリマー粉末を5リットルの水中で ホモミキサーを使用して15分間の洗浄を2回行い、1

20°Cで5時間熱風乾燥してポリイミドシロキサン粉 末、340gを得た。得られたポリイミドシロキサンは 対数粘度(30°C)は0.24であり、イミド化率は 実質的に100%であった。

【0028】実施例3~4及び比較例1~6 芳香族テトラカルボン酸成分とジアミン成分として、第 1表に示す種類及び量(モル比)を使用したほかは、実 施例1と同様にして、ポリイミドシロキサン(イミド化・ 率は実質的に95%以上)をそれぞれ製造した。それら

[0029]

【表1】

		テトラカルポン酸		ジアミン		ポリイミドシロキサン	
		種類	モル数	種類	モル数	の溶	解 性
						THF	アセトン
	1	s-BPDA	250	DAPS	150	0	×
実				BAPP	100		
	2	s-BPDA	300	DAPS	200	0	<b>x</b> .
施		a-BPDA	100	BAPP	200		
	3	s-BPDA	200	DAPS	100	0	×
例				BAPP	100		
	4	s-BPDA	200	DAPS	150	• ©	×
				. BAPP	50		
	1	s-BPDA	200	<del></del>		×	×
				BAPP	200		
比	2	a-BPDA	200	DAPS	200	0	0
	3	s-BPDA	200	DAPS	200	0	Δ
較						•	
~	4	a-BPDA	250	DAPS	150	0	0
				BAPP	100		
	5	PMDA	250	DAPS	175	×	×
69				BAPP	75		
	6	BTDA	250	DAPS	175	×	×
				BAPP	75		

PMDA: ピロメリット酸二無水物 , BTDA: 3,4,3,4 - ベンゾフェノン デトラカルボン酸二無水物

# [0030]

【発明の効果】この発明のポリイミドシロキサンは、ジ アミノポリシロキサンに基づく構成単位をかなり高い割 合で有している柔軟なポリマーであるので、耐熱性、電 50 ・電子部品の洗浄工程で使用されるアセトンやメタノー

気特性及び機械特性を保持していると共に、有機溶媒へ の可溶性(特に、メチルジグライム、テトラヒドロフラ ンに対する溶解性)が極めて優れており、しかも、電気 9

ルに対しての優れた耐薬品性を示すものである。

フロントページの続き

(72)発明者 園山 研二

大阪府枚方市中宮北町 3 番10号 宇部興産 株式会社枚方研究所内